
	<h2>SI1965DH-T1-E3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI1965DH-T1-E3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2P-CH 12V 1.3A SC70-6</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI1965DH-T1-E3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 20382 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI1965DH-T1-E3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 12V 1.3A SC70-6
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	20382 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1.25W
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6 (SOT-363)
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.3A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	390 mOhm @ 1A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4.2nC @ 8V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	120pF @ 6V
Verpackung	Tape & Reel (TR)






SI1965DH-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI1965DH-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1965DH-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1965DH-T1-E3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>SI1958DH-T1-GE3</b> VISHAY VISHAY SOT363	 <b>SI1965DH-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 12V 1.3A SC70-6	 <b>SI1965DH-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 12V 1.3A SC70-6	 <b>Si1965DH</b> Vishay Precision Group Si1965DH Vishay
 <b>SI1958DH-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 1.3A SC70-6	 <b>SI1965DH-E3</b> VISHAY SI1965DH-E3 VISHAY	 <b>SI1967DH-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 1.3A SC70-6	 <b>SI1965DH-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 12V 1.3A SC70-6

### heiße Teile

Mehr

 SI1905DL-T1	 SI1905DL-T1-E3	 SI1905DL-T1-E3	 SI1905DL-T1-GE3	 SI1906DL-T1
 SI1912EDH	 SI1912EDH-T1	 SI1912EDH-T1-E3	 SI1912EDH-T1-E3	 SI1912EDH-T1-GE3
 SI1913DH-T1-E3	 SI1913DH-T1-E3	 SI1913DH-T1-GE3	 SI1913EDH-T1	 SI1913EDH-T1-E3
 SI1913EDH-T1-E3	 SI1913EDH-T1-GE3	 SI1917EDH-T1	 SI1917EDH-T1-E3	 SI1917EDH-T1-E3
 SI1917EDH-T1-GE3	 SI1922EDH-T1-GE3	 SI1922EDH-T1-GE3	 SI1926DL-T1-E3	 SI1926DL-T1-E3
 SI1926DL-T1-GE3	 SI1926DL-T1-GE3	 SI1958DH-T1-E3	 SI1958DH-T1-E3	 SI1965DH-E3
 SI1965DH-T1-E3	 SI1965DH-T1-GE3	 SI1965DH-T1-GE3	 SI1967DH-T1-E3	 SI1967DH-T1-E3
 SI1967DH-T1-GE3	 SI1967DH-T1-GE3	 SI1969DH-E3	 SI1970DH-T1-GE3	 SI1970DH-T1-GE3
 SI1972DH-T1	 SI1972DH-T1-E3	 SI1972DH-T1-E3	 SI1972DH-T1-GE	 SI1972DH-T1-GE3
 SI1972DH-T1-GE3	 SI1973DH-E3	 SI1983DT-285-T1-E3	 SI1988DH-T1-GE3	 SI1988DH-T1-GE3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited